## МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина основы электроники Лабораторный практикум №7

> Работу выполнил: студент группы ИУ7-31Б Костев Дмитрий

> > Работу проверил:

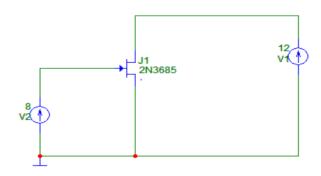
**Цель работы:** получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах

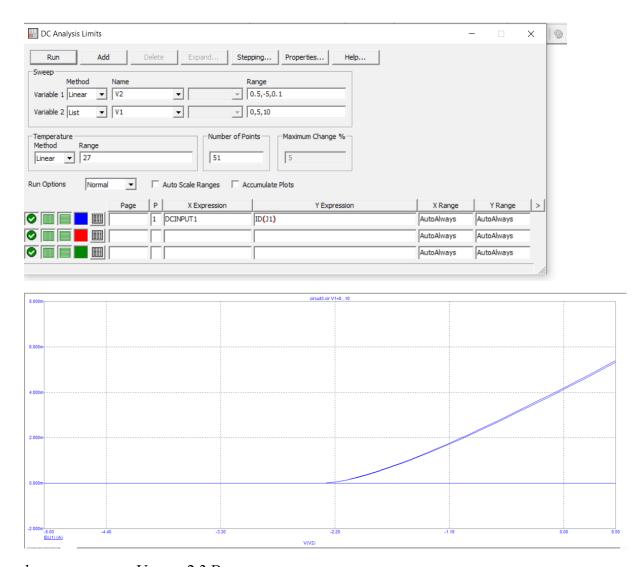
Используемые транзисторы:

10 Костев Дмитрий иу7-315 10 - D2d251b 10 - q2T325a 2N3685 IRF630 IRF9630

#### Эксперимент 7

Передаточная характеристика NFJET:





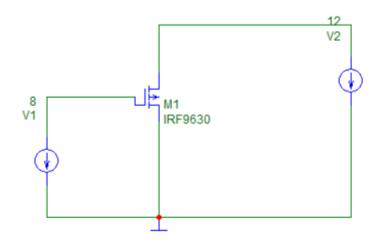
По графику видно, что Uoтс = 2.3 В.

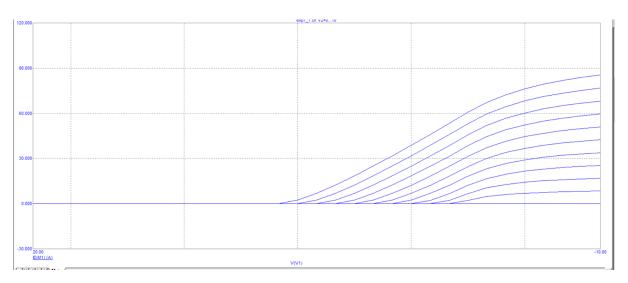
Для определения тока стока рассмотрим пересечение полученных графиков с нулевой осью абсциссы (Uзи = 0) – см. таблицу нижу.

Для 2 расчета крутизны транзистора воспользуемся формулой: Smax =  $(2I_{c\ \text{нач}})/U_{\text{отс}}$ 

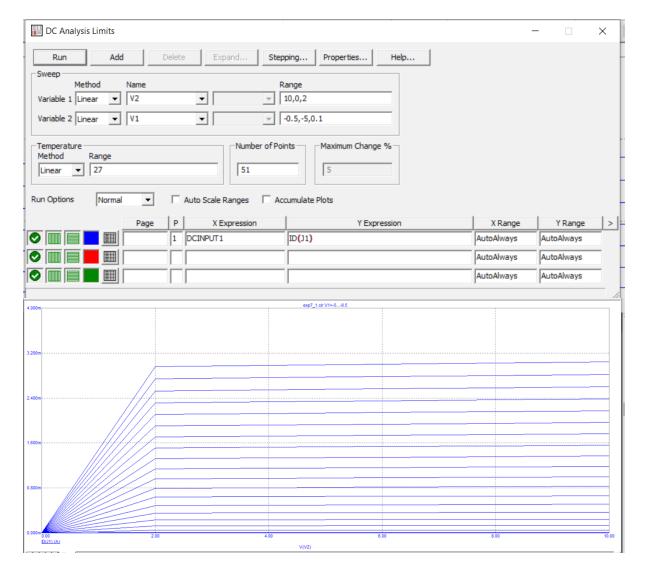
U	Іс нач мА	S <sub>max</sub>
2	4.112	2 * 4.112 / 2.3 = 3.57m
5	4.196	2 * 4.196 / 2.3 = 3.65m

### Передаточная характеристика PMOS:



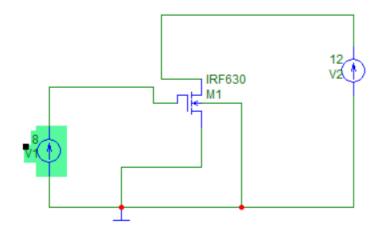


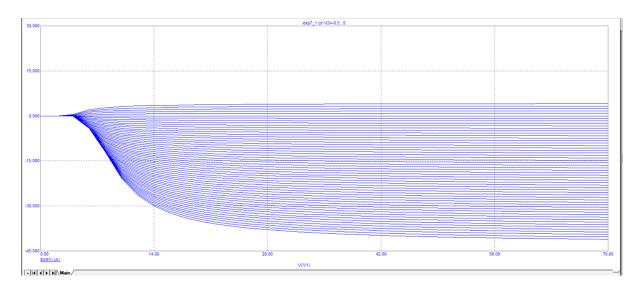
Построим выходную характеристику JFET, используются схемы из предыдущих пунктов данного эксперимента:



Как видно из графика, на промежутке от 0 до 2 B следует крутая область, переходящая потом в область насыщения.

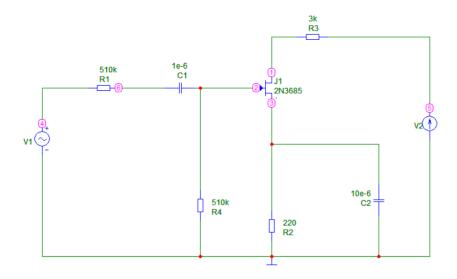
Выходная характеристика NMOS:

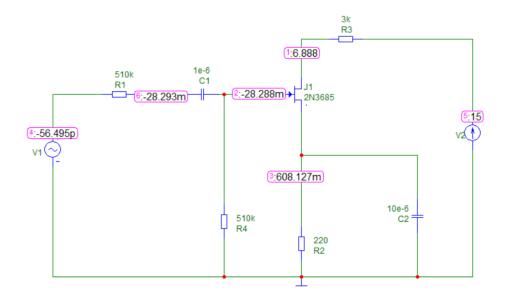


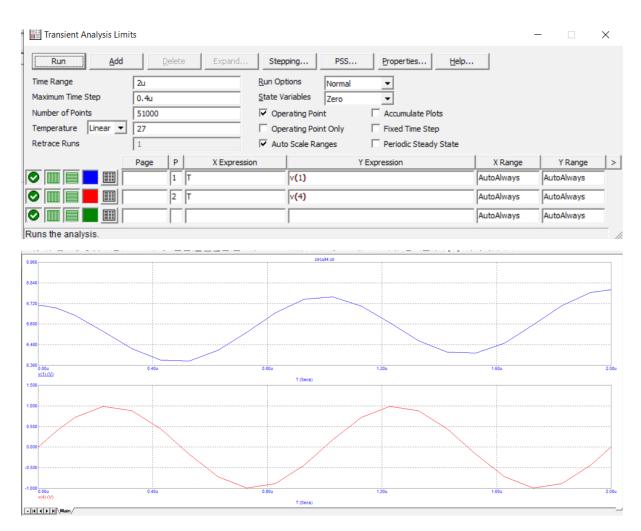


Крутая область на промежутке  $0-40~\mathrm{B},$  область насыщения – после  $40~\mathrm{B}.$ 

Включение JFET в схему с общим истоком и цепью автосмещения:

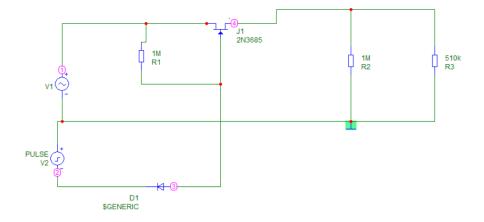


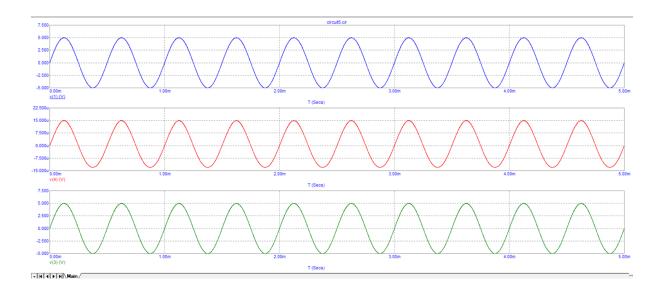




Расчèт усиления по напряжению: (6.75 - 6.38) / (0.02 + 0.02) = 9.25

# Эксперимент 8





# Эксперимент 9

## Схема КМОП цифрового ключа:

